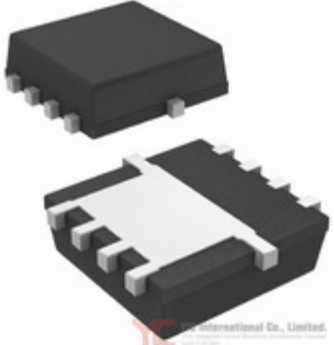


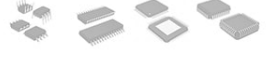

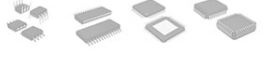





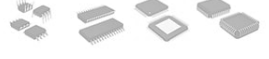




	<h2 style="color: #D9534F;">SIS406DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIS406DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 9A 1212-8 PPAK
	Datenblätter:  SIS406DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 225798 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIS406DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 9A 1212-8 PPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	225798 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta)

SIS406DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS406DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS406DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIS406DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>SIS402DN-T1-GE3 QFN8 VISHAY SIS402DN-T1-GE3 QFN8 VISHAY</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>SIS406DN-T1-E3 VISHAY SIS406DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>SIS406DN-T1-GE3-S VISHAY SIS406DN-T1-GE3-S VISHAY</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>SIS407ADN VISHAY VISHAY MSOP</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>SIS407ADN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SIS402DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>SIS406DN SI SIS406DN SI</p>	 <p>SIS407ADN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 18A 1212-8 PPAK</p>

SIS406DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Vishay / Siliconix	SIS406DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS406DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS406DN-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIS406DN-T1-GE3
SIS406DN-T1-GE3 Electronic	SIS406DN-T1-GE3 Komponenten	SIS406DN-T1-GE3 Hersteller	SIS406DN-T1-GE3 Verteiler	SIS406DN-T1-GE3 Bild	SIS406DN-T1-GE3 Teil
SIS406DN-T1-GE3 Preis	SIS406DN-T1-GE3 Original	SIS406DN-T1-GE3 Bild	SIS406DN-T1-GE3 garantiert	SIS406DN-T1-GE3 RFQ	SIS406DN-T1-GE3 Inventar
SIS406DN-T1-GE3 Neu					SIS406DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited